

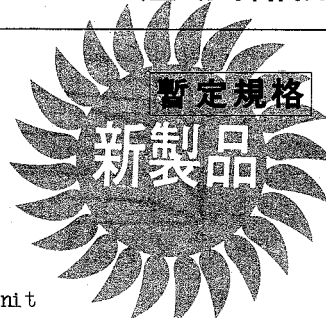


三洋半導体
ニュース

No. 956
9031

2SK332

シリコン N チャンネル接合型複合電界効果トランジスタ
差動増幅用



- 特長
- ・熱的平衡性に優れ DC アンプの初段差動増幅に最適である。
 - ・ベア性に優れている。
 - ・ノイズレベルが低い。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}	40	V
ゲート・ドレイン電圧	V_{GDS}	-40	V
ゲート電流	I_G	10	mA
ドレイン電流	I_D	20	mA
許容損失	P_D	200	mW
全損失	P_T	400	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-40~+125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

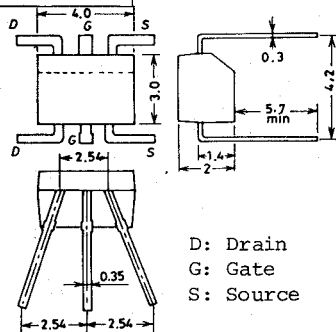
			min	typ	max	unit
ゲート・ドレイン降伏電圧	$V_{(BR)GDS}$	$I_G = -100\mu\text{A}$	-40			V
ゲートシャ断電流	I_{GSS}	$V_{GS} = -20\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			-1.0	nA
ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$, パルス	1.2※		12※	mA
ドレイン電流比	-	$V_{DS} = 10\text{V}, I_{DSS}$ 小 / I_{DSS} 大,	0.9			
カットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 10\mu\text{A}$		-0.5		V
ゲート・ソース間電圧差	ΔV_{GS}	$I_{V_{GS} \text{大}} - V_{GS} \text{小}, V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1\text{mA}$,			30	mV
相互コンダクタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1\text{kHz}$		17		mS
相互コンダクタンス比	-	$V_{DS} = 10\text{V}, y_{fs} $ 小 / y_{fs} 大,	0.9			
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		13		pF
帰還容量	C_{rss}	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		3		pF
雑音指数	NF (1)	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, R_g = 1\text{k}\Omega, f = 100\text{kHz}$	1.0	3.0		dB
"	NF (2)	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, R_g = 1\text{k}\Omega, f = 1\text{kHz}$	0.6	1.5		dB
出力雑音指数	V_{NO}	指定測定回路参照, $V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1\text{mA}$, $R_g = 100\Omega, 100\text{dB (IHF-A) Amp}$		35		mV

※ 2SK332 は 10 V I_{DSS} 小 によりつぎのように分類している。

1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------

外形図 2027
(unit: mm)

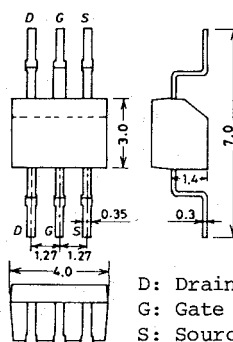
SANYO: DP6A



D: Drain
G: Gate
S: Source

外形図 2028

(unit: mm) SANYO: DP6B



D: Drain
G: Gate
S: Source

* これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。